



空间软X射线单光子雪崩探测器

- 报告人:纪慧敏
- 单 位:中国科学院微电子研究所
- 导师:李志华研究员,刘曼文副研究员
- 日 期: 2024年5月25日





- 02 基本原理
- 03 器件设计与仿真
- 04 结果分析
- 05 未来展望

 X 射线相对于可见光和红外是一种波长极短的电磁波,波长在 0.01~10 nm 之间,按 照谱段划分波长小于 0.1 nm 的为硬 X 射线,波长大于 0.1 nm 的为软 X 射线。
 空间软X射线一般指能量为0.5-10 keV的电磁波,对应波长范围为0.124-2.48 nm。





- ✓ 探索深空科学问题,研究天体的特性和结构
- ✓ 用于生物医学成像、蛋白质晶体学和分子生物学等研究
- ✓ 用于地球物理、地质学和环境科学等领域的研究
- ✓ 在 X 射线通信、空间灾害与环境监测等诸多方面有望发挥有效的作用。 地质勘探 脉冲星导航 X射线医学成像





器件设计与仿真 结果分析 未来展望





原理

- ■决定着光子能量分辨能力、响应速度和灵敏度等关键指标
- 硅基半导体探测器通常被用来进行软 X 射线探测。
 - ➤ 硅漂移探测器 (Silicon Drift Detector, SDD)
 - ▶ 电荷耦合探测器 (Charge-coupled Device, CCD)
 - ➤ 侧面碰撞探测器 (Side Collision Detector, SCD)
 - ▶ 雪崩光电二极管探测器 (Avalanche Photo Diode, APD)
 - ▶ 单光子雪崩光电探测器 (Single Photon Avalanche Diode, SPAD)



硅基半导体探测器

分类	特点	优点	缺点
SDD	通过侧向耗尽原理进行工作	时间分辨率(微秒级)、 能量分辨率较高、低功 耗、小型化	对环境要求较高, 需要 低温工作环境
CCD	采用半导体探测器面阵形式	高空间分辨率、大面积 覆盖	封装较厚,可能会增加 探测器本身的质量
SCD	通过舍弃光子位置信息,来换取较快的读出速率	漂移距离较短、低功耗	光子能量分辨率较低
APD	在 PIN 探测器半导体本征区外加一层雪崩层,配 合升压电路,在探测时达到雪崩效果	高增益、响应速度快	暗电流较大
SPAD	采用单光子计数技术	光子能量分辨率高、时 间分辨率高、响应速度 快、灵敏度高、抗辐射 性能好	易受击穿电压稳定性影 响

SPAD能够准确标记X 射线单光子到达时间,从而提高空间软X射线探测器性能,推动空间天文研究、X 射线脉冲星导航、空间 X 射线通信等诸多领域的进一步发展。







- 02 基本原理
- 03 器件设计与仿真
- 04 结果分析
- 05 未来展望

空间软X射线单光子雪崩探测器







- 02 基本原理
- 03 器件设计与仿真
- 04 结果分析
- 05 未来展望

新型三维电极单光子雪崩倍增探测器





器件设计与仿真 结果分析

- 采用n-on-p SPAD结构,在中央位置通过 掺杂梯度形成倍增区,由于空间辐照背景 的影响,增益控制在50以下,
- 通过TCAD仿真研究不同掺杂浓度等参数 对探测器暗电流和增益的影响,来优化电 场分布。
- 通过设计深宽比高的三维电极来使得偏置
 电压施加电极以及实现电学隔离,减小串
 扰并有效提高阵列的填充因子,减少"死
 区"比例。

未来展望



P+掺杂浓度分别为 1e16/1.4e16/1.8e16/2.2e16/2.6e16/2.7e16/2.8e16/2.9e16/3e16/3.1e16/3.2e16/3.3e16/3.4e16 cm⁻³

电场分布



横向电场分布





P+掺杂浓度分别为 1e16/1.4e16/1.8e16/2.2e16/2.6e16/2.7e16/2.8e16/2.9e16/3e16/3.1e16/3.2e16/3.3e16/3.4e16 cm⁻³



纵向电场分布







原理

结论: 折中考虑,选择P+掺杂浓度为2.8e16 cm-3,中间电场区虽还未达到全耗尽状态,但反向饱和 电压在100V左右,在y接近保护环深度处电场也没有急剧下降到趋近于0,保护环边界处电场可以降到 1.8e5 V/cm 且雪崩区电场可达到3.6e5 V/cm。



未来展望

器件设计与仿真 结果分析



同理,对N+区保护环深度、宽度以及N++区深度等参数均进行优化仿真,最终折中选择下图所示两种器件结构,二者各有优势,<mark>左图电场较好,右图耗尽状态较好。</mark>

器件结构2

器件结构1



0 10 20 > ntration (cm^-3 30 40 50 -30 -20 -10 10 20 0 30 Ň



同理,对N+区保护环深度、宽度以及N++区深度等参数均进行优化仿真,最终折中选择下图所示两种器件结构,二者各有优势,<mark>左图电场较好,右图耗尽状态较好。</mark>

电场分布1



电场分布2





同理,对N+区保护环深度、宽度以及N++区深度等参数均进行优化仿真,最终折中选择下图所示两种器件结构,二者各有优势,<mark>左图电场较好,右图耗尽状态较好。</mark>

空穴浓度分布2

空穴浓度分布1















通过Heavylon 模型模拟软X射线单光子入射时的器件响应电流,选用高能粒子能量为1 keV,入射深度为0.7 μm

高能粒子电荷密度1



高能粒子电荷密度2





通过Heavylon 模型模拟软X射线单光子入射时的器件响应电流,选用高能粒子能量为1 keV,入射深度为0.7 μm

响应电流曲线1











- 02 基本原理
- 03 器件设计与仿真
- 04 结果分析
- 05 未来展望

- ■本文仿真了新型三维电极雪崩倍增探测器的电势、电场、空穴浓度等电学分
 - 布,以及暗电流和电容等电学参数。
- ■通过Heavylon 模型模拟软X射线单光子入射时的器件响应电流,可以通过 计算得到器件的增益
- ■仿真发现在达到响应电流峰值前器件1和2有不同的波动,可能是由于硅体未完全耗尽导致,后续将做进一步研究。







- 02 基本原理
- 03 器件设计与仿真
- 04 结果分析
- 05 未来展望

空间软X射线单光子雪崩探测器

- ■将通过与传统平面电极探测器的仿真结果进行对比,来考察新型器件的倍增 性能。
- ■进一步对器件进行优化设计,使得该新型三维电极单光子雪崩倍增探测器不 仅具有一定的倍增效果,同时保持探测器低暗电流与低电容的性能优势,提 高器件响应速度以及灵敏度,有效拓宽低能软X射线的探测下限。
- ■在仿真完成后将进行对该器件的版图绘制、工艺开发和流片测试。



[1] ACERBI F, GUNDACKER S. Understanding and simulating SiPMs[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research SectionA: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2019, 926:16-35.

[2] 孙鸣捷,王知冠.基于单光子雪崩二极管阵列的成像技术研究进展(特邀)[J].光子学报,2022,51(08):188-204.

[3] S. Shimada, et al., "A Back Illuminated 6 µm SPAD Pixel Array with High PDE and Timing Jitter Performance," IEDM, pp. 20.1.1-4, Dec. 2021.

[4] 董联庆,杨立欣,苏云,等.空间X射线探测技术发展新趋势[J].航天返回与遥感,2022,43(04):67-77.



